First Hit

Generate Collection

L12: Entry 5 of 5

. File: JPAB

Feb 22, 1982

PUB-NO: JP357032576A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57032576 A

TITLE: PRODUCTION OF INSOLUBLE ELECTRODE

PUBN-DATE: February 22, 1982

Search Forms

ISEENTAPRENTAPHON:

MAPP.

HIROSE, TAKASHI User Searches

Preferences ASSIGNEE-INFORMATION:

Lagout

COUNTRY

COUNTRY

MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD

APPL-NO: JP55105103

APPL-DATE: August 1, 1980

US-CL-CURRENT: <u>429/209</u> INT-CL (IPC): H01M 4/96

ABSTRACT:

PURPOSE: To form stably an insoluble elecdrode which is excellent in workability, strength, high conductivity or the like, by applying onto a substrate a paste, then drying, sintering, and cooling slowly the substrate; the former paste being prepared by mixing liquid <u>ceramics</u> and carbon powder, and then by kneading well.

CONSTITUTION: The liquid <u>ceramics</u> whose principal ingredient is alumina or silica, is added with carbon powder to make a mixture, which is mixed and kneaded well to produce a <u>ceramic</u> paste paint. The metal substrate is covered with this paste at an ordinary temperature, and then dried. Next, it is heated and calcined in an electric furnace, then removed from the furnace and cooled slowly. As for the painted layer prepared by this process, a crack does not occur, this painted layer is excellent in workability, so that electrode which satisfies the insolubility, impermeability, mechanical strength and high conductivity is obtainable at a low price.

ø

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO& Japio

geeef

e h

BEST AVAILABLE COPY

f

① 日本国特許庁(JP)

⑩公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭57.—32576

(f) Int. Cl.³ H·01 M 4/96 識別記号

庁内整理番号 7268-5H 砂公開 昭和57年(1982)2月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑤不溶性電極の製造方法

01特

願 昭55-105103

20出

願 昭55(1980)8月1日

⑩発 明 者 広瀬尚

東京都品川区大崎二丁目1番17

号株式会社明電舎内

⑪出 願 人 株式会社明電舎

東京都品川区大崎2丁目1番17

号

⑩代 理 人 弁理士 佐藤正年

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

不溶性電衝の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1) カーポン粉末と主成分がアルミナ或いはシリカからなる液状セラミックスとを混練してカーポンセラミックスペーストをつくり、これを乾燥、焼成、徐冷することを特徴とする不溶性電極の製造方法。
- 2) 特許請求の範囲第1項の方法において、前記 カーボンセラミックスペーストを金属基板表面 上に塗布した後、これを乾燥、焼成、徐冷する ことを特徴とする不溶性電板の製造方法。

ックスとを混練してつくつたカーポン・セラミックスペーストを強布し、乾燥、焼成、徐冷することを特徴とする不溶性電極の製造方法。

- 4)特許請求の範囲第1項の方法において、前配 カーポン・セラミックスペーストを半硬化する まで乾燥後、プラスチック成型枠中で加温加圧 して成型し、これを焼成、徐冷することを特徴 とする不溶性電極の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は亜鉛・臭素、塩素電池等に用いる不溶性電板の製造方法に関する。

従来、亜鉛ー臭素、塩素電池の陽極電極としては、Ptメッキチタン電極、ReC 焼付チタン合金電性、Ptメッキチタン電極、ReC 焼付チタン合金電板等が提案され、メンラック・ト電板・カーボングラック・ト電をよって、からではないのでは、ないのでは、ないのでは、は、は、ないのであった。

更に、不溶性電極として知られるFezOa FeO、FeO、FezOa Ni Oa PbOz、ブラスチック含浸グラファイト(カーボン)電極、グラッシーカーボン電極等があるが、とれ等も不溶安定範囲に制約があり、或いは加工性に離点のあるもの、高導電性、不浸透性、良好な加工性、安価等要求される諸条件を満足させる。なのでしい電極の開発が望まれていた。

本発明は、前記従来の電極の欠点を除去し、安定且つ安価で、加工性に優れ、不溶性、不浸透性、機械強度大、高導電性を満足する不溶性電板の製造方法を提供するものである。

本発明の方法は、カーボン粉末(グラファイトカーボン粉末、カーボン粉末又はカーボンブラック粉末)と主成分がアルミナ或いはシリカからなる被状セラミックスとを混練してカーボンーセラミックスペーストをつくり、これを乾燥、焼成、徐冷して不容性電価とするもので、

径及びこれに配合するカーボンの粉径は、両者を 退練してつくられるペースト及びそれを金属表面 上に塗布乾燥して得られる導電性被獲層の性質に 大きな影響を及ぼす。特にセラミックス 優別の粉 径は被覆層と金属との密着性、不受透性、乾燥時 に生じ易い被影層内の微細なクラックの有無に関係し、実施結果によればその粉径は 0.1 µ以下、 更に望ましくは 0.0 1 µ以下がよい。

(2)カーボン粉末:本発明の方法に用いるカーボン 放末は、カーボンブラック微粉末、カーボン粉末、 グラファイト粉末或はその混合粉である。粉径は カーボンブラックで 0.01 µ以下、カーボン粉末、 グラファイト粉末で添常 0.5 ~ 0.1 µ程度である。 これらの粉末はセラミックスとよく混練されての たれらの粉末はセラミックスとよく混練されての ためになるべく微粉であることが望ましく、 が変になる。 ためになるべく微粉であることが望ましく、 おりになるであることが望ましく、 をは 0.01 µ以下が望ましい。 なまましている。 ないまする。

この方法において原料として用いられるものは 次の如き特性を有するものである。

(1) セラミックス: 本発明の方法において用いるセラミックスは、セラミックスの歓粉が溶滅中にコロイド状に帰摘した液状セラミックスである。セラミックス骸粉は王成分がアルミナ (A-L₂O₂)、シリカ(SiO₂)であり、その粉径は U.1 μ ~ U.0 1 μ程度である。後述の通りこのセラミックス骸粉の粉

特開稿57-82576(2)

ポンプラック粉末(例えばケッチェンプラック) が良好な紡界を示した。

(3) 混合割合:上記カーボン粉末とセラミックスとの混合割合は、後述の実施例に示す通りであるが、一般的にカーボン粉末の割合をふやせば被習層の薄電性を向上させ得るが、反面金属層との密着不良、不浸透性不良、クラックの発生を誘発するために混合割合に限界がある。又、上記不良及び導電性は層の厚みにも大きく依存し、被散層の実際的な関外は後述の実施例に見られるように500μ~100μ程度が望ましい。

(4) 添加剤:上記密芽性、不浸透性等の不良を防止するために、上記方法によつて生成したセラミックスーカーポンペーストに対して更に添加剤を添加混練すると効果的で、添加剤としてはケイ酸ナトリウム(水ガラス)、ケイ酸カルシウム等が好ましい。添加量はペーストに対してその重量パーセントで25~3mtをの範囲である。

以下実施例に基いて本発明の方法の説明を行う。 実施例 1.カーポンプラックーセラミックス層の 形成(1)

本実施例の工程は第1図のフローシートに示される。

被状セラミックスの主剤 7.0 g に対し硬化剤 3.0 g を混練し、カーボンブラック粉末 0.6 を 添加、よく混練し、セラミックスーカーボンペーストをつくつた。このペースト中にケイ酸ナトリウムを 2.5 g 添加し再びよく混練した。

生成したペーストを純アルミ(39.9%)の基板表面上に常温にて塗布し、常温乾燥後、100℃で10分間乾燥した。乾燥後の塗布層の状態を観察するために、試料表面を顕微鏡観察(400倍)を行つたところ、クラックは全く生じておらず、又塗布層の厚さは25μであつた。

更に、試料を電気炉中で 1 0 0 c / Hrの昇温速度で 3 5 0 c まで加熱焼成し、 3 5 0 c で 3 0 分間保持後、炉中より取出し空冷した。

焼成後の表面状態を観察するために、試験片の 表面の顕微鏡観察を行い、又 5 0 % 濃度の濃塩酸 中に浸漉してクラックの有無を確めたところ、試

表 - 1 〇 ··· クラックの発生なし△ ··· 一部 クラック発生× ··· 全てクラック発生

敵布厚さ Xg	0. 1 ==	0.3 ===	0.5 mm	比抵抗 Ω α=
0. 1	0	0	. 0	300~500
0. 2	0	0	Δ	5~10
0. 3	Δ	×	×	0.1~0.2

又、カーポン量の増加にともなつて、比抵抗の減少を示している。

上記後布された試験片を、炉中で300℃~350℃で30分間焼成した後、徐冷した。 加熱時の急速加熱及び冷却時の急冷はクラック発生の原因となり、100℃/Hr程度の加熱冷却が適当であつた。

上記のクラック発生は、カーボンーセラミックスペーストの塗布時の下地に大きく左右され、金属下地上に直接塗布するよりも、後述の実施例4、5の如くにして一度カーボンーセラミックスペース

験片はクラックのない良好な歯布層に被われていた。

次にこの電極を用いて電池試験を行つた結果、 電流密度 4 0 mA/ al × 5 Hr の充放電で 3 0 サイク ル以上経過しても特性の劣化はなかつた。

実施例 2.カーポンプラックーセラミッかス層の 形成(2)

前記と同じ液状セラミックス(主刺+硬化剤)を用い、カー、ボンブラック粉末 0.1 9、 0.2 9、 0.3 9の夫々に対し、セラミックス 3.3 9 (主剤)+1.0 9 (硬化剤)を退練し、ベーストを作つた。上記ベーストを用い、子め梨地研磨後25 m f % HC l 液中にて 7 0 ℃ で 3 0 分間化成処理をほどこしたチタン基板の表面に厚さ 0.1 mm ~ 0.5 mm の範囲で強布を行つた。

これらの試験片を常温空気中に放置し、乾燥を行つたところ、張ー1に示す通りのクラック発生があつた。クラックの発生状態から、盤布層の厚さは 0.1 mm … 0.2 mm 程度を限度とすることが好ましいと考えられる。

トを動布した面上に強布することがクラック防止 上有効である。

実施 例 3. グラファイトカー ポンーセラミックス 層の 形成

本実施例の工程は実施1と同じく第1図のフロ - シートに示される。

液状セラミックス (主剤及び硬化剤) とグラファイトカーボン粉末との配合は、グラファイトカーボン粉末 0.8 g、1.0 g、1.5 gの3 種に対しセラミックス主剤3.3 g、硬化剤1.0 gの割合で行い、混錬してカーボンーセラミックスペーストを作つた。

常温で上記ペーストが硬化しないうちに、子め 製地研磨後25 mt 5 HC 2 液中にて70 C で 30分間 化成処理したチタン基板の表面に強布し、厚さ0.1 22~0.5 22の層を形成した。これらの試験片を常 温放置乾燥を行つたが、その際20分経過後表面 にクラックを生じたものがあり、その傾向は強布 厚さ及びカーポン量に関係し、表-2 に示す如く であつた。従つてクラック発生防止のためには、 前配グラファイトカーポン配合量は 1.0 g 以下、 歯布厚さは 0.3 m以下でなければならない。

表 - 2

(グラフアイト量 X9 / 3.3 9主剤+1.09 硬化剤)

競布厚さ Xg	0.1 ==	0. Зив	0. 5 ==
0. 8	0	0	Δ
1. 0	0	0	<u> </u>
1. 5	Δ	×	×

┌○ … クラツクの発生なし

△…一部クラック発生

し× …全てクラック発生

上表により、グラファイトカーポン・セラミックス層は前述のカーポンプラック層に比較して、カーポンの割合が増加してもクラックが発生しにくいことがわかる。

次に、上記試験片を炉中で350℃で30分間 焼成した。この際前記乾燥時にクラックを発生し ないものは、そのましクラックの発生を見ずに焼 成を終えた。焼成後の冷却は、急冷はクラック発

上にクランクの発生のないことを確認して、加熱 炉中で300℃~350℃で30分間加熱焼成し、 徐冷した(昇温、降温速度は100℃/Hr)。

以上の処理によって得られたクラックのない試験片を亜鉛-臭素電池の関係として用い 電解を行った結果(電流密度 1 2 0 =A/cd)臭素の発生を見、電解終了後試験片を検査したところ、外観上及び密着上異状を認めなかった。

実施例 5. 彼層塗布による電極の製作(2)

実施例 4 に示したと同様に、チタン基を上にグラファイトカーボンーセラミックス層を強布、焼付、冷却し、その上に前項と同様な配合のカーボンブラック・セラミックが止を目的として、この強布の際、クラック防止を目的として、ストに 0.5 ccの水を添加し低粘度に希釈後、0.1 mm で放置乾燥を行つた結果、クラックのない良好な強布面を得た。

上記の試験片を、加熱炉中で300℃~350℃ で30分間の加熱焼成を行い徐冷した結果、良気 生の原因となるので、徐帝しなければならない。 焼成を終えた試験片の抵抗を測定したところ、 比抵抗 $\rho \simeq 0.05$ $\Omega \simeq$ 程度であつた。

上記クラックの発生状況及び抵抗値から、グラファイトカーポンーセラミックスペーストの能布厚さは、0.2~03 ** 程度が好ましい値である。

実施例 4. 種層飲布による電極の製作(1)

本実施例の工程は第2図のフローシートに示される。

的記実施例 1 ~ 3 の 結果に基 き、前処理したチョン 落板上に、グラファイトカー ポン粉末 1.0 gと、液状セラミンクス (主剤 3.3 g、硬化剤1.0 g)とを混練したベーストを 0.3 平厚さに 強布し、常治大気中に放電乾燥後、加熱炉で 3 0 0℃~350℃ (1 0 0 ℃ / Br で発温)で 3 0 分間加熱焼成し、100℃ / Br で徐冷した。

次に、この試験片上に、カーポンプランク粉末
0.39と放状セラミックス(主剤 3.39、硬化剤
1.09)とを規模したベーストを 0.1 mm ~ 0.2 mm
の関さに始布し、常道大気中に放徹乾燥後、表面

なカーポンプラックーセラミックス盤布面を有する電信が得られた。

ベーストの水添加希釈は、二度塗り、三度塗りを行うことを可能とし、必要な厚さの、 クラックのない 強布層を得るために有効であつた。

実施例 6.カーポンセラミックス単体による配極 の製作

本実施例の工程は、第3図のフローシートに示される。

前述の実施例に示した電極の製作は、チャン基 牧上にペーストを強布することによりカーボンー セラミックス階を作るものであるが、基板を用い ずにカーボンーセラミックス層を作りこれを電板 とすることも可能である

それは、前述の如き被状セラミックス又は液性セラミックスペーストと、グラファイトカーポン粉末或いはカーボンブラック粉末とを現職してペーストを作り、これを半乾燥後、加温圧縮成型するもので、以下にその工程について述べる。

グラファイトカーポン粉末 1.5 g に対して丧失

特開昭57-32576(5)

田舘成型後、各飲験片を加熱炉中で300℃~350℃で30分間焼成を行い、徐冷した(加熱及び冷却速度は100℃/Hr)。

上記の如くにして作られた各試験片の比抵抗は、 グラファイトーセラミックス系では0.01~0.02Ω on

(4)前述の原料(金属基板、カーポン粉末、セラミック液等)及び製造工程(混練、塗布、乾燥、成のから明かなよりに、特に高価な原料を用いるとなく、又複雑高度の技術を要するものでないので、本発明の方法によれば、移めて安価に、且つ安定した品質の電衝を供給することが出来る。(5)前述したメッキ電極、酸化物電極、カーボン電

程度で、カーポンプラック~セラミックス系では 0.1~0.5 Ω α 程度で、良好な不溶性電極が得られた。

以上述べた本発明の不溶性電極の製造方法によれば、以下の如き効果が得られる。

(1)従来から知られているカーボン(含グラファイト)の良好な不活性触媒性を利用し、金属を応じ、たっきックスを介して塗布、焼付することにより、金属層の有する高い電気伝導性、機械強度、加工性等をベースとして、カーボンの良好な触性を付与した、不溶性の耐薬品性の高い、且つ安価な電板が得られる。

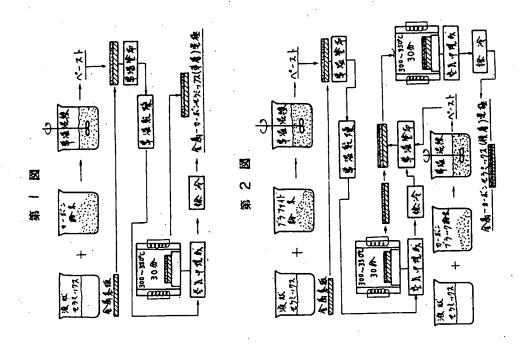
(2) 従来の、カーボンとブラスチックを混練、加熱加工されたカーボンブラスチック電極は、ブラスチック電極は、ブラスチック電極は、ブラスチック電極は、ブラスを選性、機械強度、電導性等に取引があるが、本発明によればブラスチックに相当するパインダーがセラミックスであるであるブラスチックよりもはるかに優れた特性を有する電極をつくることが出来、更に、使用される

無等の有する時間題点を解決して、本発明の方法による電極は、不容性、不受抗性、電導性、力の点で使れた性質を有する。 (6)金属表面上に強布して用いる以外に、カーボンーセラミック単体を加熱圧縮成型して、必要な大きさ及び形状の電気を製造し、電池用電をとかが出現用電板その他不容性電極として用いることが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の方法による金属ーカーボンセラミックス(単層)電板製造の工程図、第2 図は同じく金属ーカーボンセラミックス(視層)電板製造の工程図、第3 図は同じくカーボンセラミックスフィルム電極製造の工程図である。

代理人 弁理士 佐 聯 正 年 代理人 弁理士 木 村 三 朗 代理人 弁理士 佐 本木 宗 治



BEST AVAILABLE COPY

